

Сведения о члене экспертной комиссии

1	ФИО (полностью)	Каргин Николай Иванович
2	Дата рождения (полная)	19.11.1954
3	Гражданство	Российская Федерация
4	Ученая степень (с указанием шифра специальности научных работников, по которой защищена диссертация)	Доктор технических наук по специальности 02.00.04 физическая химия
5	Ученое звание (по кафедре, специальности)	Профессор
6	Место работы:	
	Почтовый индекс, адрес, web-сайт, электронный адрес организации	115409, Москва, Каширское ш., 31, https://mephi.ru/ , info@mephi.ru
	Полное наименование организации в соответствии с уставом	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».
	Ведомственная принадлежность организации	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
	Тип организации	ФГАОУ ВО
	Наименование подразделения	Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
	Должность	Проректор
7	Основные публикации в области диссертационного исследования:	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gaponenko, N. V., Staskov, N. I., Sudnik, L. V., Vityaz, P. A., Luchanok, A. R., Karnilava, Y. D., Kargin, N. I. Upconversion Luminescence from Sol-Gel-Derived Erbium-and Ytterbium-Doped BaTiO₃ Film Structures and the Target Form //Photonics. – MDPI, 2023. – Т. 10. – №. 4. – С. 359. 2. Fronya, A. A., Antonenko, S. V., Karpov, N. V., Pokryshkin, N. S., Eremina, A. S., Kargin, N. I. Pulsed laser deposition in He-N₂ gaseous mixtures for the synthesis of photoluminescent Si and Ge nanoparticles for bioimaging //Nanoscale and Quantum Materials: From Synthesis and Laser Processing to Applications 2023. – SPIE, 2023. – Т. 12410. – С. 37-45. 3. Sibirmovsky Y. D., Vasil'evskii I. S., Kargin N. I. Modeling the absorption and refraction spectra of multiple quantum well structures //Materials Today: Proceedings. – 2023. – Т. 80. – С. 2620-2624. 4. Nizovtsev, A. P., Kukin, N. S., Muradova, A. R., Semenov, P. A., Salkazanov, A. T., Smirnova, M. O., Kargin N. I. Vector Magnetometry Using a Single NV-13C Complex in Diamond //Journal of Applied Spectroscopy. – 2023. – Т. 89. – №. 6. – С. 1064-1071. 5. Salkazanov, A. T., Smirnova, M. O., Tarelkin, S. A., Gusev, A. S., Drozdova, T. E., Kaloshin, M. M., Kargin N. I. Investigation of Isotopic Composition and Purity of 13C-Enriched CVD-Diamond Layers by Raman Spectroscopy and Photoluminescence //Journal of Applied Spectroscopy. – 2023. – Т. 89. – №. 6. – С. 1059-1063. 6. Lokotko V. V., Vasil'evskii I. S., Kargin N. I. Development of a Method for Constructing a Nonlinear Model of a Metamorphic 0.15-μm MHEMT InAlAs/InGaAs Transistor //Russian Microelectronics. – 2022. – Т. 51. – №. 6. – С. 404-412. 	

7. Borisenko, D. P., Gusev, A. S., **Kargin, N. I.**, Dobrokhoto, P. L., Timofeev, A. A., Labunov, V. A. Few-Layer Graphene as an Efficient Buffer for GaN/AlN Epitaxy on a SiO₂/Si Substrate: A Joint Experimental and Theoretical Study //Applied Sciences. – 2022. – Т. 12. – №. 22. – С. 11516.
8. Долинский И.Ю., Катин К.П., Гришаков К.С., Прудковский В.С., **Каргин Н.И.**, Маслов М.М. Влияние механического растяжения на адсорбционные свойства легированного азотом графена //Физика твердого тела. - 2018. - Т. 60. - №. 4. - с. 816-820.
9. Виниченко А.Н., Сафонов Д.А., **Каргин Н.И.**, Васильевский И.С. Электронный квантовый транспорт в псевдоморфных и метаморфных квантовых ямах на основе In_{0.2}Ga_{0.8}As //Физика и техника полупроводников. -2019. -Т. 53. -№. 3. - С. 359-364.
10. Сафонов Д.А., Виниченко А.Н., **Каргин Н.И.**, Васильевский И.С. Электронный транспорт в квантовых ямах AlGaAs/InGaAs/GaAs PHEMT при различных температурах: влияние одностороннего дельта-легирования Si / /Физика и техника полупроводников. - 2018. -Т. 52. -№. 2. -С. 201-206.

8	Контактный телефон члена экспертной комиссии (желательно мобильный)
9	Адрес электронной почты